

KT611AM, KT611BM

ТРАНЗИСТОРЫ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ MEDIUM-POWER HIGH-FREQUENCY TRANSISTORS

Транзисторы KT611AM, KT611BM предназначены для работы в усилителях напряжения, в релаксационных генераторах, в ключевых схемах и другой радиотехнической аппаратуре широкого применения.

Si-n-p-n-P

The KT611AM, KT611BM transistors are designed for use in voltage amplifiers, relaxation oscillators, switching circuits and other radio equipments in a wide range of applications.

28

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДАННЫЕ $t_{case} = -25...+100^{\circ}C$

MAXIMUM RATINGS

$I_{C\ max.}, mA$	100
$U_{EB\ max.}, V$	4
$U_{CB\ max.}, V$	200
$U_{CE\ max.} (R_{BE} \leq 1\ k\Omega), V$	180

$P_{C \max.}$ ($t_{case} \leq 25^\circ C$), W:

с теплоотводом*

heat sink*

без теплоотвода**

free air**

3

0,8

$t_{j \max.}$, $^\circ C$

150

* При

$$At \quad t_{case} > 25^\circ C \Rightarrow P_{C \max.} = \frac{150 - t_{case}}{40}$$

** При

$$At \quad t_{amb} > 25^\circ C \Rightarrow P_{C \max.} = \frac{150 - t_{amb}}{150}$$

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	KT611AM	KT611BM	Режимы Conditions
1	2	3	4
$I_{EBO}, \mu A$	≤ 100		$U_{EB} = 3 V$
$I_{CES}, \mu A$	≤ 200		$U_{CE} = 180 V$
h_{21E}	10-40	30-120	$U_{CB} = 40 V$ $I_E = 20 mA$
$ h_{21e} $	≥ 3		$U_{CB} = 40 V$ $I_E = 20 mA$ $f = 20 MHz$

1	2	3	4
$U_{CE \text{ sat}}, V$	≤ 8		$I_C = 20 mA$ $I_B = 2 mA$
C_c, pF	≤ 5		$U_{CB} = 40 V$ $f = 2 MHz$
τ_c, ps	≤ 200		$U_{CB} = 20 V$ $I_E = 20 mA$ $f = 2 MHz$

